

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-183201

(43)Date of publication of application : 21.07.1995

(51)Int.Cl.

H01L 21/027
G03F 7/20

(21)Application number : 05-345162

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 21.12.1993

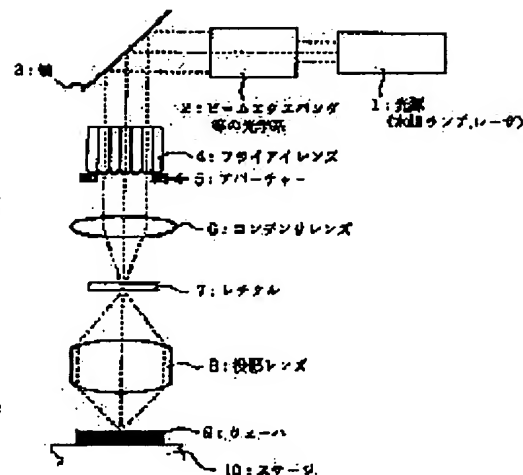
(72)Inventor : KASAMA KUNIIHIKO

(54) EXPOSURE DEVICE AND METHOD THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the resolving power and the focal depth near the marginal resolution by a method wherein the illumination component by TE polarization waves in the parallel direction with a pattern surface is increased by obliquely illuminating with linearly polarized light.

CONSTITUTION: The beam emitted from a light source 1, after passing through an optical system 2, e.g. a beam expander, etc., to be reflected by a mirror 3, are made an even parallel beam by passing through a flyeye lens 4. At this time, an aperture 5 is arranged beneath the flyeye lens 4. The parallel beam passing through the aperture part of the aperture 5 and a condenser lens 6 obliquely illuminates a reticle 7, and a wafer 9 after passing through a projection lens 8. At this time, polarizers arranged on respective aperture parts of the applicable aperture 5 opposite to one another and apart by 180° are set up to make the polarizing direction parallel with each other. Through these procedures, the resolving power and the focal depth near the marginal resolution can be increased.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 09.08.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 04.02.1997

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The aligner characterized by being in the aligner which has an oblique-incidence means by which incidence of the beam of light from the light source is aslant carried out to a reticle, and having the polarizer which makes the above-mentioned beam of light linearly polarized light light.

[Claim 2] The stage in which a substrate is carried, and the light source which irradiates the beam of light which carries out incidence to this substrate, The fly eye lens arranged between the reticle arranged between the light source and a stage, and a reticle and the light source, The aligner characterized by being arranged between a fly eye lens and a reticle, being in the aligner equipped with the oblique-incidence member which carries out incidence of the beam of light from the light source aslant to a reticle, and having the polarizer which makes the beam of light which carries out oblique incidence to a reticle from the above-mentioned oblique-incidence member linearly polarized light light.

[Claim 3] The above-mentioned polarizer is an aligner according to claim 2 which makes parallel the plane of polarization of the linearly polarized light light to a substrate side.

[Claim 4] It is an aligner given in any 1 term of claims 1, 2, or 3 with which the above-mentioned oblique-incidence member has the aperture prepared between the above-mentioned fly eye lens and the reticle, and this aperture was equipped with opening annularly arranged in respect of being perpendicular to the optical axis and which were matched for this opening with the above-mentioned polarizer.

[Claim 5] The above-mentioned aperture is an aligner according to claim 4 which has opening allotted in the shape of zona orbicularis.

[Claim 6] An aligner given in any 1 term of claims 1, 2, 3, 4, or 5 which prepared the projection lens which projects the beam of light which penetrated the reticle on a substrate front face between the above-mentioned reticle and the stage.

[Claim 7] The above-mentioned light source is an aligner given in any 1 term of claims 1, 2, 3, 4, 5, or 6 containing the laser which irradiates polarization light.

[Claim 8] The exposure approach characterized by carrying out oblique incidence of the linearly polarized light light to a transferred object in the exposure approach which irradiates a beam of light at a transferred object, and imprints the pattern of a transferred object on an imprint object.

[Claim 9] The above-mentioned linearly polarized light light is the exposure approach according to claim 8 which made the plane of polarization parallel to the field where the pattern of an imprint object is imprinted.

[Claim 10] The above-mentioned linearly polarized light light is the exposure approach according to claim 9 by which incidence is carried out [two or more] to a transferred object from a light source field.

[Claim 11] The linearly polarized light light from [above-mentioned / two or more] a light source field is the exposure approach according to claim 10 that the polarization direction of the linearly polarized light light from [which counters] a light source field is parallel.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to amelioration of an oblique-incidence exposure technique especially about the aligner and the exposure approach which are used for photograph RISOGURAFU processes, such as a semiconductor device and an electronic circuitry, etc.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the demand to implementation of a detailed pattern is increasing with high integration of LSI. Conventionally, the main force of this detailed pattern formation technique (RISOGURAFU technique) is an aligner which uses g line (436nm) or i line (365nm) of a mercury lamp, and is the ultraviolet-rays exposure technique which combined the stepper and the novolak system resist. And high resolution-ization of a novolak system resist has been attained together with the improvement in the engine performance of a stepper (a raise in NA of a lens, improvement of superposition precision, etc.). Consequently, micro processing of a pattern with a width of face of about 0.35-0.40 micrometers is becoming possible.

[0003] However, when high definition is aimed at further, in extension of the conventional technique, it is becoming clear gradually that it cannot be coped with. Therefore, the further short-wavelength-izing and the various super resolution technique (for example, KrF excimer laser light (249nm) or mercury arc lamp light near 250nm etc.) (a phase shift mask, oblique incidence lighting, and pupil filter) are proposed, and examination is made. Also in this, short wavelength-ization is the universal technique. Moreover, oblique incidence lighting is explained below using the projection aligner shown in drawing 5.

[0004] As shown in drawing 5, in this projection aligner, the optical system 2 of a beam expander etc. is penetrated, it is reflected in a mirror 3, and the beam of light injected from the light source 1 turns into a uniform parallel ray by the fly eye lens 4. This parallel ray passes circular opening of an aperture 5. This light that passed is irradiated by the reticle 7 through a condensing lens 6, further, penetrates the projection lens 8 and is irradiated by the wafer 9.

[0005] The oblique incidence exposure approach using the zona-orbicularis lighting aslant illuminated to a reticle 7 using this projection aligner is stated to the 217th page of "Proceeding of KTI Microelectronics seminar (1989)" by the binary name besides D.L.Fehrs. Moreover, this approach is indicated by several persons besides M.Noguchi at the 753rd page of "SPIE Vol.1674 Optical/Laser Microlithography V (1992)", and is indicated by several persons besides the 92nd page of this reference, or N.Shiraishi by trinominal besides KTounai at the 741st page of this reference.

[0006] The aperture shown in drawing 6 (a) - (e) is used for this oblique incidence exposure approach instead of the above-mentioned aperture 5 (drawing 5) which has circular opening. That is, the aperture 11 of the 10 or 4 aperture lighting of two-point lighting, the aperture 13 of the 12 or 8 aperture lighting of zona-orbicularis lighting, or the aperture 14 of four-point (rectangle) lighting is arranged directly under the fly eye lens 4. This approach is the technique of eliminating a part for zero-order Mitsunari which carries out incidence perpendicularly to a reticle 7, being only a beam of light for slanting zero-order Mitsunari, and illuminating a reticle 7 with the zona-orbicularis-like beam of light which passed these openings. According to this zona-orbicularis-like beam of light, whenever [between a part for zero-order Mitsunari and a part for a part for +primary Mitsunari and -primary Mitsunari / angle-of-diffraction / large] can be taken. For this reason, whenever [image formation face angle] becomes large as compared with the former, and resolution improves. Moreover, the contrast in an image formation side increases and the depth of focus improves.

[0007] Furthermore, the technique of using the polarization light at the time of exposure is indicated by JP,61-218132,A. This technique has prevented the multiple echo effectiveness within the image formation

optical system located between a transferred object (reticle) and an imprint object (wafer). This installs the circular polarization of light generating section which consists of a linearly polarized light plate and a phase polarizing plate (quarter-wave length plate) in image formation optical system.

[0008] Moreover, the technique indicated by JP,1-260452,A has controlled the scattered light and the diffracted light on a wafer side or inside a reticle by installing the polarization film in the opposite side of a reticle pattern side, and exposing by turning a metal reticle pattern side up further.

[0009] Furthermore, if TM polarization wave (it is a vertical polarization wave to the direction of incidence and TE polarization wave) carries out incidence while resolution will increase if TE polarization wave (wave parallel to a wafer side) carries out incidence in parallel with a pattern side when exposing using polarization light, it is expected by the simulation that resolution falls rather than the case where it is unpolarized light. For example, it is indicated by several persons besides Y.Unno at the 879th page of "Proceeding of SPIE, 1927 (1993)." As shown in drawing 7, in the case of TE polarization wave, the electric field of the zero-order diffracted light and the electric field of this of the primary [**] diffracted light correspond with space in a perpendicular direction. For this reason, contrast improves. On the other hand, TM polarization wave is because each electric field of the zero-order diffracted light and the primary [**] diffracted light slope mutually, so contrast deteriorates conversely.

[0010]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] To be sure, it is effective in improvement in resolving power and the depth of focus, and it is only changing an aperture and application to the aligner is also easy for the oblique incidence exposure mentioned above. However, the amount of improvement is comparatively small, and the actual condition is inquired rather than contraction of the device design Ruhr bearing expansion of a process margin in mind.

[0011] Moreover, originally the above-mentioned technique using polarization light does not pursue high definition, and does not prevent degradation of the optical image by multiplex interference of exposure optical system, dispersion, and diffraction, and large high definition cannot be desired.

[0012] Furthermore, although the simulation of the above-mentioned polarization light exposure shows the effectiveness of TE polarization wave, it does not show clearly in fact how it applies to real device manufacture.

[0013] Then, the purpose of this invention is to offer the aligner and the exposure approach resolution and whose depth of focus improve.

[0014]

[Means for Solving the Problem] Invention indicated to claim 1 is the aligner equipped with the polarizer which is in the aligner which has an oblique-incidence means by which incidence of the beam of light from the light source is aslant carried out to a reticle, and makes the above-mentioned beam of light linearly polarized light light.

[0015] The stage in which invention indicated to claim 2 carries a substrate, and the light source which irradiates the beam of light which carries out incidence to this substrate, The fly eye lens arranged between the reticle arranged between the light source and a stage, and a reticle and the light source, It is the aligner which has the polarizer which makes the beam of light which is arranged between a fly eye lens and a reticle, is in the aligner equipped with the oblique-incidence member which carries out incidence of the beam of light from the light source aslant to a reticle, and carries out oblique incidence to a reticle from the above-mentioned oblique-incidence member linearly polarized light light.

[0016] Invention according to claim 3 is an aligner according to claim 2 with which the above-mentioned polarizer makes parallel the plane of polarization of the linearly polarized light light to a substrate side.

[0017] It is an aligner given in any 1 term of claims 1, 2, or 3 with which the above-mentioned oblique-incidence member has the aperture prepared between the above-mentioned fly eye lens and the reticle in invention indicated to claim 4, and this aperture was equipped with opening annularly arranged in respect of being perpendicular to the optical axis and which were matched for this opening with the above-mentioned polarizer.

[0018] Invention according to claim 5 is an aligner according to claim 4 which has opening to which the above-mentioned aperture was allotted in the shape of zona orbicularis.

[0019] Invention indicated to claim 6 is an aligner given in any 1 term of claims 1, 2, 3, 4, or 5 which prepared the projection lens which projects the beam of light which penetrated the reticle on a substrate front face between the above-mentioned reticle and the stage.

[0020] Invention indicated to claim 7 is an aligner given in any 1 term of claims 1, 2, 3, 4, 5, or 6 containing the laser with which the above-mentioned light source irradiates polarization light.

[0021] It is the exposure approach that ***** carries out oblique incidence of the linearly polarized light light to a transferred object at claim 8 in the exposure approach that invention irradiates a beam of light at a transferred object, and imprints the pattern of a transferred object on an imprint object.

[0022] The above-mentioned linearly polarized light light of invention according to claim 9 is the exposure approach according to claim 8 by which the pattern of an imprint object made the plane of polarization parallel to the field imprinted.

[0023] Invention indicated to claim 10 is the exposure approach according to claim 9 by which incidence of the above-mentioned linearly polarized light light is carried out [two or more] to a transferred object from a light source field.

[0024] The linearly polarized light light from [of the above-mentioned plurality / invention / which was indicated to claim 11] a light source field is the exposure approach according to claim 10 that the polarization direction of the linearly polarized light light from [which counters] a light source field is parallel.

[0025]

[Function] The principle of oblique-incidence exposure of the linearly polarized light light concerning this invention is explained taking the case of zona-orbicularis lighting. As shown in drawing 1 , Polarizer P is arranged so that the polarization direction of opening which counters the aperture section A which has the ring-like opening O among two or more openings may be in agreement. The type which extended the polyvinyl alcohol (PVA) which can penetrate ultraviolet radiation as a polarizer P, the so-called Polaroid system HN film, and KN film are applicable. Moreover, it is also possible to use a calcite, Xtal, a quartz, or the birefringence mold polarizer that consists of fluorite. Furthermore, a polarizing prism etc. is applicable.

[0026] The transparency cross multiplier which generally expresses contrast on the strength [optical] with the lap of the effective light source and a pupil function: It is determined by the ratio for a part for zero-order Mitsunari of TCC, and primary [**] Mitsunari. Moreover, an angle of diffraction becomes large, so that a pattern becomes dense. This angle of diffraction theta is searched for by $\theta = \sin^{-1}(\lambda/p)$. However, lambda shows exposure wavelength and p shows a pattern pitch. If an angle of diffraction becomes large, in order that the lap of the effective light source and a pupil function may decrease, a part for **primary Mitsunari of TCC is decreased gradually. Consequently, in unpolarized light exposure, contrast on the strength [optical] decreases, so that a pattern becomes dense, and it becomes resolving impossible at the last.

[0027] On the other hand, with the zona-orbicularis lighting which has arranged Polarizer P, the component of TE polarization wave parallel to the direction of a pattern increases as a pattern becomes dense and whenever [angle-of-diffraction] increases. For this reason, contrast on the strength [optical] has small attenuation compared with unpolarized light exposure, and high definition can be attained. Furthermore, attenuation of the optical contrast at the time of defocusing is also small by TE polarization wave component, and there are also few falls of the depth of focus. Therefore, the depth of focus resolving power and near the resolution limit can also be raised 10 to 20% compared with the case of unpolarized light exposure, although it is dependent on a resist.

[0028]

[Example] Hereafter, the example of this invention is explained to a detail using a drawing. Drawing 2 - drawing 5 are drawings for explaining one example of this invention. The aligner concerning this invention can use the thing of a configuration of being shown in drawing 5 .

[0029] If this projection aligner is explained with reference to drawing 5 , this equipment has the light source 1 of a mercury lamp or laser. The beam of light injected from the light source 1 penetrates the optical system 2 of a beam expander etc., and is reflected in a mirror 3. Furthermore, this reflected light serves as a uniform parallel ray by passing the fly eye lens 4. The aperture 5 is arranged directly under the fly eye lens 4. A parallel ray passes opening of an aperture 5 and is irradiated in the direction of slant through a condensing lens 6 to the reticle 7 in which the predetermined pattern was formed. Furthermore, a beam of light is a configuration which the projection lens 8 is penetrated and is irradiated by the wafer 9. In the above aperture 5 and condensing lens 6, the wafer 9 shows the substrate whose reticle 7 is an imprint object about a transferred object in an oblique-incidence member, respectively.

[0030] Here, the aperture 5 to be used has the thing in which opening of various configurations was formed in drawing 4 , as (a) - (f) shows. It is in the field of the circular aperture 5, and all arrange the field core annularly as a core, and are formed. And the polarizer mentioned above to each of these openings is arranged. The polarizer which estranged 180 degrees and was arranged in openings which counter is set up so that the polarization direction may become parallel. For example, if it is in the aperture which has

opening (refer to drawing 4 (b)) of four-point lighting, the polarizer is arranged so that the polarization direction may become parallel in opening which counters.

[0031] The comparison with the aperture which does not contain a polarizer in below is performed. In the case of the usual aperture, primary (pitch equivalent to angle of diffraction shown in drawing 2 by a and b) diffracted-light reinforcement is large to X of a specific dimension, and the direction pattern of Y, and contrast on the strength [optical] is also high. However, in order that the optical reinforcement of the primary diffracted light may decrease to the direction pattern of 45 degree compared with the zero-order diffracted light, contrast on the strength [optical] deteriorates, consequently serves as resolving impossible. On the other hand, in the case of the aperture which has arranged the polarizer of this invention, to X and the direction of Y, a property almost equal to the case where he has no polarizer is acquired. On the other hand, although primary diffracted-light reinforcement is decreased like an unpolarized light aperture, in order that TE polarization light may carry out incidence of it to parallel with the direction pattern of 45 degree to the direction pattern of 45 degree, attenuation of contrast on the strength [optical] becomes slight. The situation is shown in drawing 3 (a) and (b). Generally, as for the direction of a pattern of a semiconductor device, it is rare that they are only X and the direction of Y, and the pattern of the direction of 45 degree usually exists. This four-point lighting aperture that added the polarizer is effective not only in X and the direction pattern of Y but the direction pattern of 45 degree.

[0032] Next, this invention is explained about the case where laser beams, such as KrF and ArF, are made into the light source. Generally, a laser beam oscillates the light which carried out the linearly polarized light. Therefore, it is possible to arrange the polarization direction at the same time it operates a light source configuration orthopedically, in case this laser beam is divided by a beam splitter etc. and oblique incidence lighting is performed. Therefore, as shown in (f) of this drawing, the same effectiveness can be acquired by making in agreement the case and the polarization direction of the configuration ((e) of drawing 4) stated in the above-mentioned example.

[0033] As mentioned above, although the case where four-point lighting was applied was explained, if it is in this invention, the same effectiveness can be acquired also in other oblique incidence exposure, i.e., two-point lighting as shown in drawing 4 , eight-point lighting, or zona-orbicularis lighting.

[0034]

[Effect of the Invention] Since the component which performs oblique incidence lighting with linearly polarized light light, and is illuminated by TE polarization wave of a direction parallel to a pattern side is increased according to this invention, it has the effectiveness that the depth of focus definition and near the resolution limit is expanded. Moreover, it has the effectiveness which controls degradation of the definition of the direction pattern of 45 degree in four-point lighting.

[Translation done.]

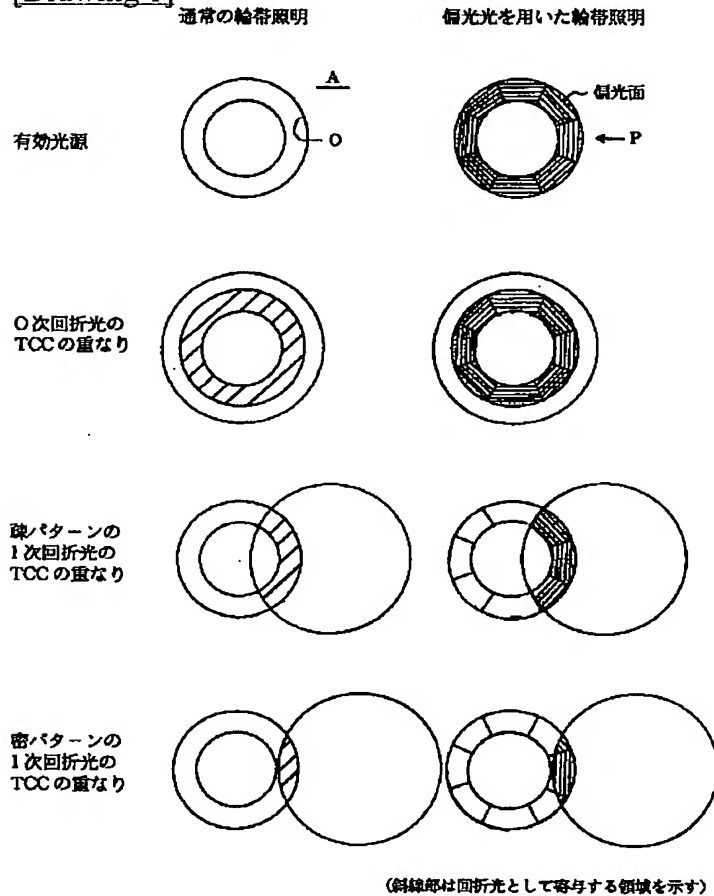
* NOTICES *

JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

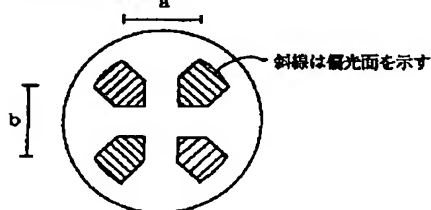
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

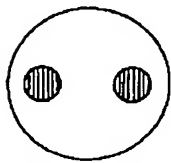
[Drawing 1]



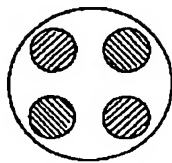
[Drawing 2]



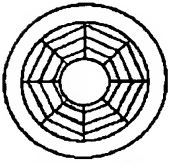
[Drawing 4]



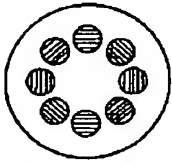
(a) 2点照明



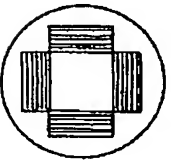
(b) 4点照明



(c) 輪帯照明



(d) 8点照明

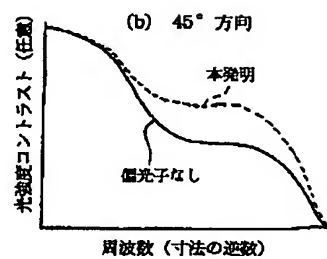
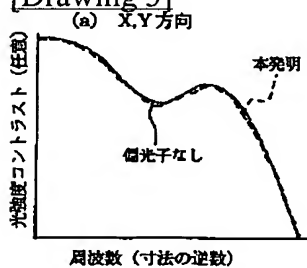


(e) 4点 (矩形) 照明

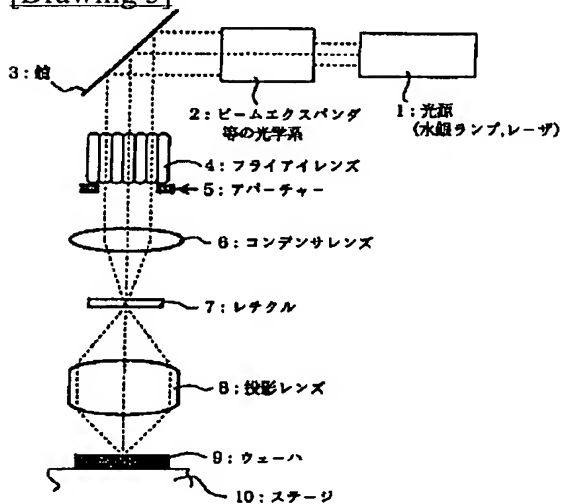
(f) レーザー光を用いた
4点 (矩形) 照明

(斜線は偏光方向を示す)

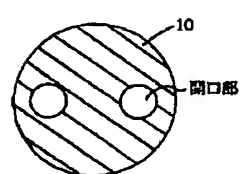
[Drawing 3]



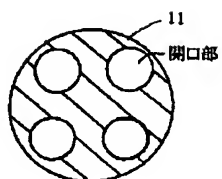
[Drawing 5]



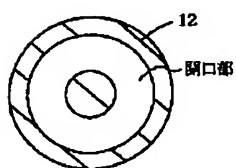
[Drawing 6]



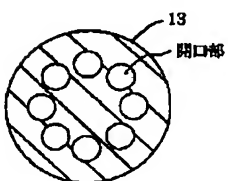
(a) 2点照明



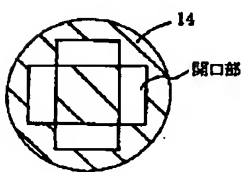
(b) 4点照明



(c) 輪帯照明

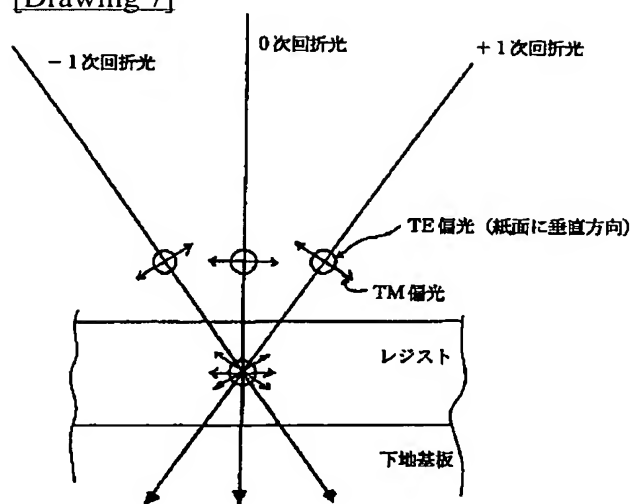


(d) 8点照明



(e) 4点(矩形)照明

[Drawing 7]



[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-183201

(43) 公開日 平成 7 年 (1995) 7 月 21 日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027				
G 0 3 F 7/20	5 2 1	7352-4M	H 0 1 L 21/ 30	5 1 5 D
		7352-4M		5 2 7
審査請求 有 請求項の数 11 F D (全 6 頁)				

(21) 出願番号 特願平5-345162

(22) 出願日 平成 5 年 (1993) 12 月 21 日

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

(72) 発明者 笠間 邦彦

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内

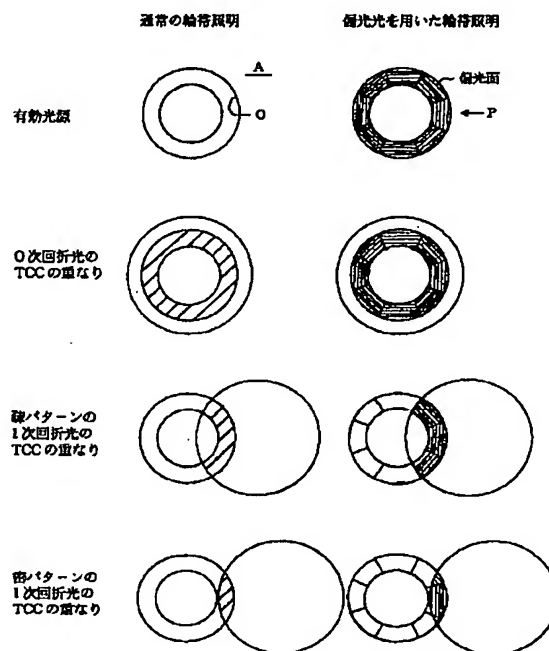
(74) 代理人 弁理士 桑井 清一

(54) 【発明の名称】 露光装置および露光方法

(57) 【要約】

【目的】 光リソグラフ技術において、通常照明方法および斜入射照明方法よりも解像力、焦点深度をさらに向上させる露光装置および露光装置を提供する。

【構成】 斜入射露光を、ウェーハ面およびパターン方向に平行な直線偏光を用いて行う。輪帯照明、4点照明等のアパーチャー開口部の対向する部分に、T E 偏光波を出すように偏光子を挿入する。または、初めから偏光した光を発振するレーザ光を分割し、斜入射照明用に配置し、偏光を揃えても良い。



(斜線部は回折光として考える領域を示す)

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 光源からの光線がレチクルに対して斜めに入射される斜め入射手段を有する露光装置にあって、上記光線を直線偏光光とする偏光子を備えたことを特徴とする露光装置。

【請求項 2】 基板を搭載するステージと、この基板に対して入射する光線を照射する光源と、光源とステージとの間に配設されたレチクルと、レチクルと光源との間に配設されたフライアイレンズと、フライアイレンズとレチクルとの間に配設され、光源からの光線をレチクルに対して斜めに入射する斜め入射部材とを備えた露光装置にあって、上記斜め入射部材からのレチクルに斜め入射する光線を直線偏光光とする偏光子を有することを特徴とする露光装置。

【請求項 3】 上記偏光子は、その直線偏光光の偏光面を基板面に対して平行とする請求項 2 に記載の露光装置。

【請求項 4】 上記斜め入射部材は、上記フライアイレンズとレチクルとの間に設けられたアパーチャーを有し、このアパーチャーは光軸に対して垂直な面で環状に配設された開口を備え、この開口には上記偏光子が配された請求項 1、2 または 3 のいずれか 1 項に記載の露光装置。

【請求項 5】 上記アパーチャーは輪帯状に配された開口を有する請求項 4 に記載の露光装置。

【請求項 6】 上記レチクルとステージとの間にはレチクルを透過した光線を基板表面に投影する投影レンズを設けた請求項 1、2、3、4 または 5 のいずれか 1 項に記載の露光装置。

【請求項 7】 上記光源は偏光光を照射するレーザを含む請求項 1、2、3、4、5 または 6 のいずれか 1 項に記載の露光装置。

【請求項 8】 光線を被転写体に照射して被転写体のパターンを転写体に転写する露光方法において、直線偏光光を被転写体に対して斜め入射することを特徴とする露光方法。

【請求項 9】 上記直線偏光光は、その偏光面を、転写体のパターンが転写される面に対して平行にした請求項 8 に記載の露光方法。

【請求項 10】 上記直線偏光光は、複数の光源領域方向から被転写体に入射される請求項 9 に記載の露光方法。

【請求項 11】 上記複数の光源領域方向からの直線偏光光は、対向する光源領域方向からの直線偏光光の偏光方向が平行である請求項 10 に記載の露光方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体装置、電子回路等のフォトリソグラフ工程等に用いられる露光装置およ

び露光方法に関し、特に斜め入射露光技術の改良に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、LSI の高集積化に伴い、微細パターンの実現に対する要求が高まっている。従来、この微細パターン形成技術（リソグラフ技術）の主力は、水銀ランプの g 線（436 nm）または i 線（365 nm）を用いる露光装置であり、また、ステッパとノボラック系レジストとを組み合わせた紫外線露光技術である。そして、ステッパの性能向上（レンズの高 NA 化、重ね合わせ精度の改善など）と合わせ、ノボラック系レジストの高解像度化が図られてきた。その結果、0.35～0.40 μm 程度の幅のパターンの微細加工が可能となりつつある。

【0003】 しかしながら、さらに高解像性を目指した場合、従来手法の延長では対処できないことが次第に明らかとなってきている。そのため、さらなる短波長化（例えば、KrF エキシマレーザ光（249 nm）または 250 nm 付近の水銀アークランプ光など）、各種超解像手法（位相シフトマスク、斜入射照明および瞳フィルタ）が提案され、検討がなされている。この中でも短波長化は最も普遍的な手法である。また、斜入射照明については、図 5 に示す投影露光装置を用いて以下説明する。

【0004】 図 5 に示すように、この投影露光装置では、光源 1 から射出された光線は、ビームエキスパンダ等の光学系 2 を透過し、鏡 3 で反射され、フライアイレンズ 4 で均一な平行光線となる。この平行光線は、アパーチャー 5 の円形の開口部を通過する。この通過した光は、コンデンサレンズ 6 を経てレチクル 7 に照射され、さらに、投影レンズ 8 を透過してウェーハ 9 に照射される。

【0005】 この投影露光装置を用いてレチクル 7 に対して斜めに照明する輪帯照明を用いた斜入射露光方法は、D. L. Fehrs 他 2 名による、「Proceeding of KTI Microelectronics seminar（1989 年）」の第 217 頁に述べられている。また、この方法は、K. Tounai 他 3 名によって、「SPIE Vol. 1674 Optical/Laser Microlithography V（1992 年）」の第 753 頁に、M. Noguchi 他数名により同文献の第 92 頁に、または、N. Shiraishi 他数名により同文献の第 741 頁に開示されている。

【0006】 この斜入射露光方法は、円形の開口部を有する上記アパーチャー 5（図 5）の代わりに、図 6

（a）～（e）に示したアパーチャーを用いるものである。すなわち、2 点照明のアパーチャー 10、4 点照明のアパーチャー 11、輪帯照明のアパーチャー 12、8 点照明のアパーチャー 13、または、4 点（矩形）照明

のアパーチャー14を、フライアイレンズ4の直下に配置したものである。この方法は、これらの開口部を通過した輪帯状光線によって、レチクル7に対して垂直に入射する0次光成分を消去して、斜め0次光成分の光線だけで、レチクル7を照明する手法である。この輪帯状光線によると、0次光成分と、+1次光成分、または、-1次光成分との間の回折角度を大きくとれる。このため、結像面角度が従来に比較して大きくなり、解像力が向上する。また、結像面でのコントラストが増大し、焦点深度が向上する。

【0007】さらに、露光時の偏光光を利用する技術が、特開昭61-218132号公報に開示されている。この技術は、被転写体（レチクル）と転写体（ウェーハ）との間に位置する結像光学系内の多重反射効果を防止している。これは、直線偏光板と位相偏光板（1/4波長板）とからなる円偏光発生部を結像光学系内に設置するものである。

【0008】また、特開平1-260452号公報に開示された技術は、レチクルパターン面の反対側に偏光膜を設置し、さらに、金属レチクルパターン面を上にして露光することにより、ウェーハ面上またはレチクル内部の散乱光および回折光を抑制している。

【0009】さらに、偏光光を用いて露光を行う場合、TE偏光波（ウェーハ面に平行な波）がパターン面に平行に入射すると解像度が増大する一方、TM偏光波（入射方向とTE偏光波に対して垂直方向の偏光波）が入射すると、非偏光の場合よりも解像度が低下することが、シュミレーションにより予想されている。例えば、Y. Unno他数名によって、「Proceeding of SPIE, 1927（1993年）」の第879頁に開示されている。これは、図7に示すように、TE偏光波の場合、0次回折光の電場と±1次回折光の電場とが、紙面に垂直方向において一致している。このため、コントラストが向上する。これに対し、TM偏光波は0次回折光と±1次回折光との各電場が互いに傾いているため、逆にコントラストが劣化するからである。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】上述した斜入射露光は、解像力、焦点深度の向上に確かに有効であり、その露光装置への適用も、アパーチャーを変更するのみであり、容易である。しかしながら、その向上量は比較的小さく、デバイス設計ルールの縮小よりも、プロセスマージンの拡大を念頭に検討されるのが実態である。

【0011】また、偏光光を利用した上記技術は、本来、高解像性を追求するものではなく、露光光学系の多重干渉、散乱、回折による光学像の劣化を防止するものであり、大幅な高解像性は望めない。

【0012】さらに、上記偏光光露光のシミュレーションは、TE偏光波の有効性を示しているものの、実際には、どのように実デバイス製造に適用するのかを明確に

示しているものではない。

【0013】そこで、本発明の目的は、解像力および焦点深度が向上する露光装置および露光方法を提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載した発明は、光源からの光線がレチクルに対して斜めに入射される斜め入射手段を有する露光装置にあって、上記光線を直線偏光光とする偏光子を備えた露光装置である。

10 【0015】請求項2に記載した発明は、基板を搭載するステージと、この基板に対して入射する光線を照射する光源と、光源とステージとの間に配設されたレチクルと、レチクルと光源との間に配設されたフライアイレンズと、フライアイレンズとレチクルとの間に配設され、光源からの光線をレチクルに対して斜めに入射する斜め入射部材とを備えた露光装置にあって、上記斜め入射部材からのレチクルに斜め入射する光線を直線偏光光とする偏光子を有する露光装置である。

20 【0016】請求項3に記載の発明は、上記偏光子は、その直線偏光光の偏光面を基板面に対して平行とする請求項2に記載の露光装置である。

【0017】請求項4に記載した発明は、上記斜め入射部材は、上記フライアイレンズとレチクルとの間に設けられたアパーチャーを有し、このアパーチャーは光軸に対して垂直な面で環状に配設された開口を備え、この開口には上記偏光子が配された請求項1、2または3のいずれか1項に記載の露光装置である。

30 【0018】請求項5に記載の発明は、上記アパーチャーは輪帯状に配された開口を有する請求項4に記載の露光装置である。

【0019】請求項6に記載した発明は、上記レチクルとステージとの間にはレチクルを透過した光線を基板表面に投影する投影レンズを設けた請求項1、2、3、4または5のいずれか1項に記載の露光装置である。

【0020】請求項7に記載した発明は、上記光源は偏光光を照射するレーザを含む請求項1、2、3、4、5または6のいずれか1項に記載の露光装置である。

【0021】請求項8に記載した発明は、光線を被転写体に照射して被転写体のパターンを転写体に転写する露光方法において、直線偏光光を被転写体に対して斜め入射する露光方法である。

【0022】請求項9に記載の発明は、上記直線偏光光は、その偏光面を、転写体のパターンが転写される面に対して平行にした請求項8に記載の露光方法である。

【0023】請求項10に記載した発明は、上記直線偏光光は、複数の光源領域方向から被転写体に入射される請求項9に記載の露光方法である。

【0024】請求項11に記載した発明は、上記複数の光源領域方向からの直線偏光光は、対向する光源領域方向からの直線偏光光の偏光方向が平行である請求項10

に記載の露光方法である。

【0025】

【作用】本発明に係る直線偏光光の斜め入射露光の原理を、輪帯照明を例にとって説明する。図1に示すように、リング状開口Oを有するアパーチャー部Aに、複数の開口部のうち対向する開口部の偏光方向が一致するように偏光子Pを配置する。偏光子Pとしては、紫外光を透過することができるポリビニルアルコール(PVA)を引き伸ばしたタイプ、いわゆるポラロイド系HN膜、KN膜を適用することができる。また、方解石、水晶、石英、または、蛍石からなる複屈折型偏光子を用いることも可能である。さらには、偏光プリズム等も適用することができる。

【0026】一般に、光強度コントラストは、有効光源と瞳関数の重なりで表す透過クロス係数：TCCの0次光成分と±1次光成分の比で決定される。また、パターンが密になるほど回折角は大きくなる。この回折角 θ は、 $\theta = \sin^{-1}(\lambda/p)$ で求められる。但し、 λ は露光波長、 p はパターンピッチを示す。回折角が大きくなると、有効光源と瞳関数との重なりが減少するため、TCCの±1次光成分は次第に減衰する。この結果、非偏光露光の場合は、パターンが密になるほど光強度コントラストが減少し、最後に、解像不能となる。

【0027】一方、偏光子Pを配置した輪帯照明では、パターンが密となり、回折角度が増大するにつれて、パターン方向に平行なTE偏光波の成分が増大する。このため、光強度コントラストは、非偏光露光に比べて、減衰が小さく、高解像性を達成することができる。さらに、TE偏光波成分により、デフォーカス時の光コントラストの減衰も小さく、焦点深度の低下も少ない。したがって、解像力、解像限界付近での焦点深度も、レジストに依存するが、非偏光露光の場合に比べて10~20%向上させることができる。

【0028】

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。図2~図5は本発明の一実施例を説明するための図である。本発明に係る露光装置は図5に示す構成のものを使用することができる。

【0029】図5を参照してこの投影露光装置を説明すると、この装置は、水銀ランプまたはレーザ等の光源1を有している。光源1から射出された光線は、ビームエキスパンダ等の光学系2を透過し、鏡3で反射される。さらに、この反射光は、フライアイレンズ4を通過することにより、均一な平行光線となる。フライアイレンズ4の直下にはアパーチャー5が配設されている。平行光線は、アパーチャー5の開口部を通過し、コンデンサレンズ6を経て、所定のパターンが形成されたレチクル7に対して斜め方向に照射される。さらに、光線は、投影レンズ8を透過してウェーハ9に照射される構成である。以上のアパーチャー5およびコンデンサレンズ6は

斜め入射部材を、レチクル7は被転写体を、ウェーハ9は転写体である基板をそれぞれ示している。

【0030】ここで、使用するアパーチャー5は、図4に(a)~(f)で示すように、種々の形状の開口部を形成したものがある。いずれも円形のアパーチャー5の面であって、その面中心を中心として環状に配設して形成してある。そして、これらの開口部のそれぞれに上述した偏光子を配設している。180度離間して対向する開口部同士に配設された偏光子は、その偏光方向が平行となるように設定されている。例えば4点照明の開口部(図4(b)参照)を有するアパーチャーにあっては、対向する開口部にてその偏光方向が平行になるように偏光子を配置している。

【0031】以下に、偏光子を含まないアパーチャーとの比較を行う。通常のアパーチャーの場合、特定寸法のX、Y方向パターンに対して(図2にa、bで示した回折角に相当するピッチ)1次回折光強度が大きく、光強度コントラストも高い。しかしながら、45°方向パターンに対しては、0次回折光に比べ、1次回折光の光強度が減少するため、光強度コントラストは劣化し、その結果、解像不能となる。一方、本発明の偏光子を配置したアパーチャーの場合には、X、Y方向に対しては、偏光子無しの場合とほぼ等しい特性が得られる。一方、45°方向パターンに対しては、1次回折光強度は、非偏光アパーチャー同様減衰するもののTE偏光光が45°方向パターンと平行に入射するため、光強度コントラストの減衰は軽微になる。その様子を図3(a)、(b)に示す。一般に、半導体デバイスのパターン方向は、X、Y方向のみであることはまれであり、45°方向のパターンが通常存在する。偏光子を付加したこの4点照明アパーチャーは、X、Y方向パターンのみでなく、45°方向パターンにも有効である。

【0032】次に、KrF、ArF等のレーザ光を光源とする場合について本発明の説明を行う。一般に、レーザ光は直線偏光した光を発振する。したがって、このレーザ光をビームスプリッタ等で分割して斜入射照明を行う際、光源形状を整形すると同時に、偏光方向を揃えることが可能である。したがって、同図の(f)に示すように、上記実施例で述べた形状(図4の(e))の場合とその偏光方向とを一致させることにより、同様の効果を得ることができる。

【0033】以上、4点照明を適用した場合に関してのみ説明したが、本発明にあっては、他の斜入射露光、すなわち、図4に示すような2点照明、8点照明、または、輪帯照明においても、同様の効果を得ることができる。

【0034】

【発明の効果】本発明によれば、斜入射照明を直線偏光で行い、パターン面に平行な方向のTE偏光波で照明する成分を増大させているため、解像性および解像限界

10

20

30

40

50

付近の焦点深度が拡大するという効果を有する。また、4点照明においては 45° 方向パターンの解像性の劣化を抑制する効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の偏光光露光の原理を輪帯照明を例にとって説明する図である。透過クロス係数の重なりによって0次回折成分および1次回折成分を表している。

【図2】本発明の一実施例に係る4点照明のアパーチャーを示す図である。

【図3】図2に示す4点照明において非偏光露光と偏光露光の光強度コントラストを比較した図である。(a)はX、Y方向、(b)は 45° 方向を示す。

【図4】本発明の実施例に係る偏光子を設置したアパーチャーの例、および、偏光光を発振するレーザー光源の場合の光源の配置を示す図である。

【図5】本発明の実施例および従来のステッパの光学系*

*を示す図である。

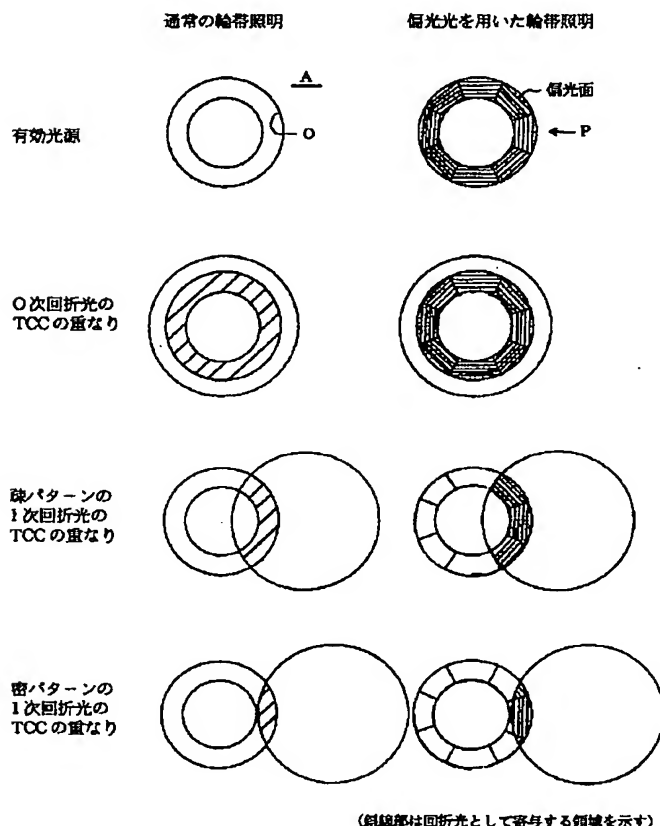
【図6】非偏光露光におけるアパーチャー形状を示す図である。

【図7】TE偏光とTM偏光の結像の相違を説明する図である。

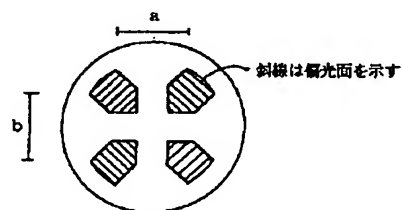
【符号の説明】

- 1：光源
- 4：フライアイレンズ
- 5：アパーチャー
- 6：斜め入射用のコンデンサレンズ
- 7：レチクル
- 8：投影レンズ
- 9：基板（ウェーハ）
- 10：ステージ
- P：偏光子

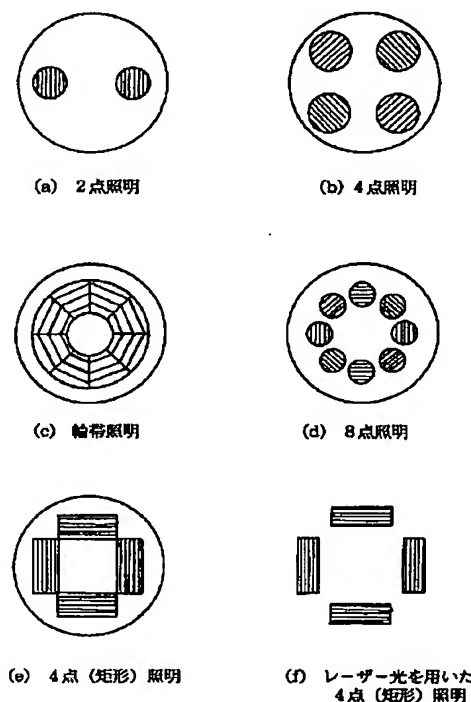
【図1】



【図2】

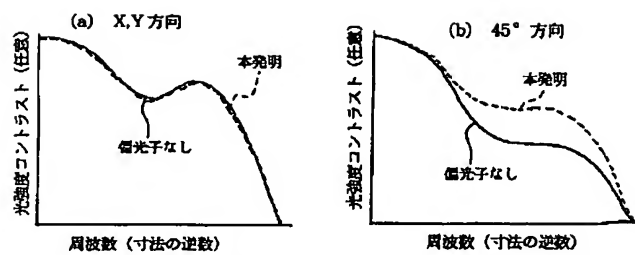


【図4】

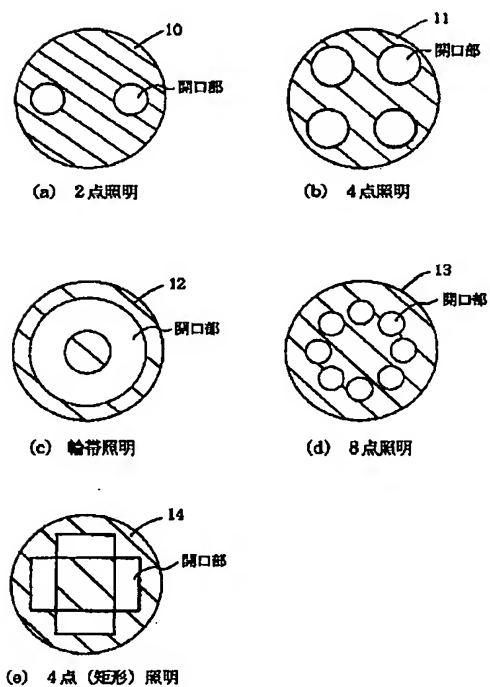


(斜線は偏光方向を示す)

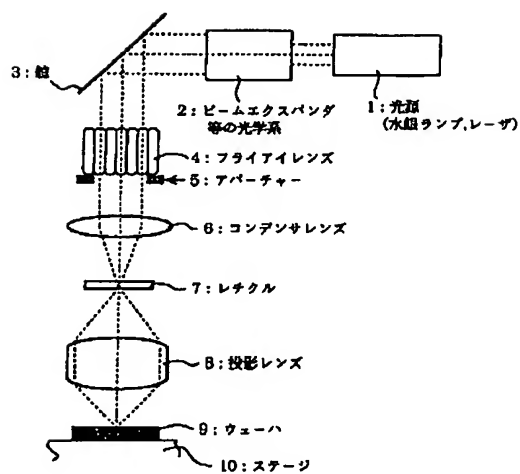
【図3】



【図6】



【図5】



【図7】

